

★電子部品・材料研究会 (CPM)

専門委員長 廣瀬文彦 副委員長 武山真弓

幹事 岩田展幸・中村雄一 幹事補佐 赤毛勇一

日時 10月27日(金) 13:20~17:30

28日(土) 9:20~12:15

会場 信州大学長野(工学)キャンパス(長野市若里4-17-1, <http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/maps/map03.html#campus> 番場教子)

議題 機能性材料(半導体, 磁性体, 誘電体, 透明導電体・半導体等) 薄膜プロセス/材料/デバイス, 一般
27日

1. 化学気相堆積した窒化ホウ素炭素膜の形成条件の検討 ○小坂舞人・浦上法之・橋本佳男(信州大)
2. SiC 溶液法における坩堝からの炭素の溶解現象と結晶品質の関係
○高橋 大・玄 光龍・土本直道・鈴木皓己・沓掛穂高・太子敏則(信州大)
3. sol-gel 法による MgSnO 薄膜作製に関する研究 ○小柳津和成・高野 泰(静岡大)
4. シリコン高効率発光の構造条件の検討 ○五島敬史郎・杉下佑磨・犬飼圭祐(愛知工大)
5. $\text{Cu}_2\text{ZnSnS}_4$ 光吸収層及び II-VI 系バッファ層の界面制御
○蓮池玲美・ミヨー タンテイ(信州大)・百瀬成空(長野高専)・伊東謙太郎・橋本佳男(信州大)
6. $\text{Cu}_2\text{ZnSnS}_4$ 化合物薄膜太陽電池の開発—プリカーサ及び基板の最適化—
○長田孝幸・ミヨー タンテイ(信州大)・百瀬成空(長野高専)・伊東謙太郎・橋本佳男(信州大)
7. 薄膜太陽電池用 $\text{Cu}_2(\text{Sn}_{1-x}\text{Ge}_x)$ S3 光吸収層の作製
○小林 純・ミヨー タンテイ(信州大)・百瀬成空(長野高専)・伊東謙太郎・橋本佳男(信州大)
8. パルスレーザー堆積法による $\text{YAlO}_3(001)$ 基板上での $\text{Ca}_{0.96}\text{Ce}_{0.04}\text{MnO}_3$ 薄膜の作製 ○小野寺 巧・平戸剛志・赤沢孝徳・小山智之・岡本卓也・宋 華平・福井慎二郎・榎本 翼・山本 寛・永田知子・岩田展幸(日大)
9. スパッタリング法による酸化物単結晶基板上での $(\text{Cr}_{1-x}\text{Fe}_x)_2\text{O}_3$ 薄膜の作製及び結晶構造解析
福井慎二郎・平戸剛志・小野寺 巧・榎本 翼・永田知子・山本 寛・○岩田展幸(日大)
10. $\text{CaFeO}_x/\text{LaFeO}_3$ 人工超格子の面直方向に関する電気特性
大橋祥平・松山裕貴・赤澤孝徳・宋 華平・小山智之・岡本卓也・永田知子・山本 寛・○岩田展幸(日大)
11. $\text{SrTiO}_3(001)$ 上に成膜した $[\text{CaFeO}_x/\text{BiFe}_{1-x}\text{Mn}_x\text{O}_3]$ 人工超格子の面直方向に関する電気特性
松山裕貴・大橋祥平・赤澤孝徳・宋 華平・小山智之・岡本卓也・永田知子・山本 寛・○岩田展幸(日大)

28日

1. MWNT 含有 PVA 膜の調製及び特性評価 横川泰貴(信州大)
2. 3次元メッシュグラフェンに関する研究 ○中西 誠・姜 天水・稲田剛基・村松寛之・林 卓哉(信州大)
3. 自由電子レーザー照射下で成長させた単層カーボンナノチューブの金属触媒膜厚依存性
高橋祐貴・保延賢人・シャーマ ロヒト・○永田知子・岩田展幸・山本 寛(日大)
4. 銅薄膜及び銅箔を触媒に用いた作製した金属インターカレート二層グラフェンの電気的特性
○鈴木雅登・倉金夏己・荒木伊久磨・永田知子・岩田展幸・山本 寛(日大)
5. LT 系固溶体セラミックスの特性 ○八木綾仁・番場教子(信州大)
6. 単結晶アシスト及び2段階焼成によるニオブ酸リチウムセラミックスの作製
高宮 開・横山裕紀・小笠原 孝・高須敬士・○番場教子(信州大)
7. 有機金属分解法を用いたビスマス高置換ネオジム鉄ガリウムガーネットの形成
○倉橋秀之・佐々木孝介・後藤太一・高木宏幸・林 攀梅・中村雄一・内田裕久・井上光輝(豊橋技科大)
8. 磁気光学イメージングのための磁気光学材料及びイメージング装置の作製に関する研究
○西本光佑・橋本良介(鈴鹿高専)・高木宏幸・後藤太一・中村雄一・リム パンボイ・内田裕久・井上光輝(豊橋技科大)

☆CPM 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

11月6日(月)~8日(水) くまもと県民交流館パレア [締切済] テーマ: デザインガイア 2017—VLSI 設計の新しい大地—

11月30日(木), 12月1日(金) 名工大 [締切済] テーマ: 窒化物半導体光・電子デバイス, 材料, 関連技術, 及び一般